

Silicon Diode

BY203/12S

1200V / 250mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

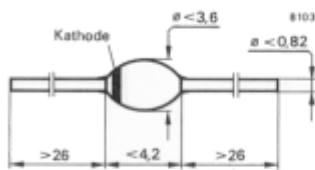
Source: Telefunken Databook 1988

BY 203/..S**Silizium-Mesa-Diode**

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. für zeilenfrequenten Betrieb im Fernsehgerät und Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse

Abmessungen in mm

Sinterglasgehäuse
SOD 57
Gewicht max. 0,5 g

Bestemp lung: Klartext**Absolute Grenzdaten**

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung

BY 203/12 S	$U_R = U_{RWM}$	1200	V
BY 203/16 S	$U_R = U_{RWM}$	1600	V
BY 203/20 S	$U_R = U_{RWM}$	2000	V

Durchlaßstrom I_F 250 mA

Stoßdurchlaßstrom I_{FSM} 20 A
 $t_p = 0,1$ ms

Sperrschichttemperatur T_J 150 °C

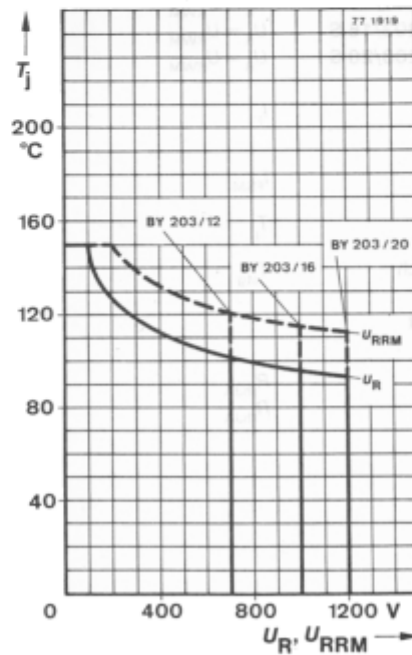
Lagerungstemperaturbereich T_{stg} - 65...+ 175 °C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung			
$l = 5$ mm, $T_L =$ konstant	R_{thJA}	50	K/W
maximale Anschlußlänge	R_{thJA}	100	K/W

BY 203/..S

		Min.	Typ.	Max.
Kenngrößen				
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung $I_F = 200\text{ mA}$		$U_F^{1)}$		2,4 V
Sperrstrom				
$U_R = 700\text{ V}$	BY 203/12 S	I_R		2 μA
$U_R = 1000\text{ V}$	BY 203/16 S	I_R		2 μA
$U_R = 1200\text{ V}$	BY 203/20 S	I_R		2 μA
Durchbruchspannung				
$I_R = 100\text{ }\mu\text{A}$	BY 203/12 S	$U_{(BR)}^{1)}$	1200	V
	BY 203/16 S	$U_{(BR)}^{1)}$	1600	V
	BY 203/20 S	$U_{(BR)}^{1)}$	2000	V
Rückwärtserholzeit				
$I_F = 0,5\text{ A}; I_R = 1\text{ A}; i_R = 0,25\text{ A}$		t_{rr}		300 ns



¹⁾ $t_p = 0,01\text{ ms}$, $t_p = 0,3\text{ ms}$